Examen final

Département de génie électrique et de génie informatique GEL-3000 – Électronique des composants intégrés

Le 26 avril 2017

Documentation permise : 2 feuilles de notes recto verso et 1 calculatrice.

Durée de l'examen : 1 heure 50 (9h30 – 11h20).

1. (30 points) Questions à courts développements

Soit le circuit de la Figure 1.

- a) Dessinez son modèle petit signal.
- b) Donnez son impédance de sortie.
- c) Donnez son gain de tension.
- d) Remplacez la source de courant idéale *I* par un circuit de polarisation. Pour ce faire, utilisez une source de courant PMOS polarisée par un miroir de courant et une résistance. **Dessinez votre circuit de polarisation.**
- e) Expliquez brièvement le fonctionnement du convertisseur illustré à la <u>Figure 2</u> et dites dans quelles circonstances il est approprié de l'utiliser.
- f) Soit le circuit montré à la <u>Figure 3</u>. Remplacez le bloc du haut (entre v₁ et v₂) par un circuit utilisant 1 ampli-op afin d'obtenir un oscillateur. Dessinez l'oscillateur complet avec le circuit que vous proposez. **Combien possède-t-il d'état stable?**

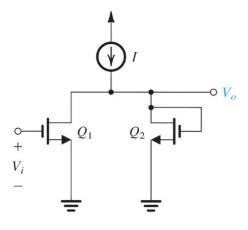


Figure 1.

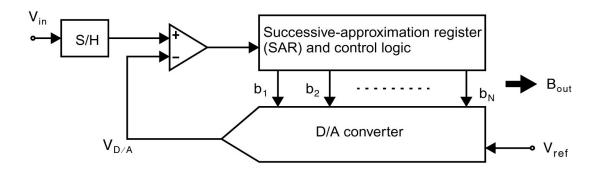


Figure 2.

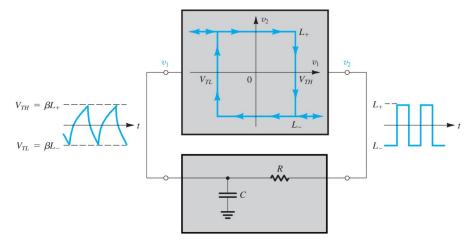


Figure 3.

2. (30 points) Analyse de circuits

Soit le circuit suivant :

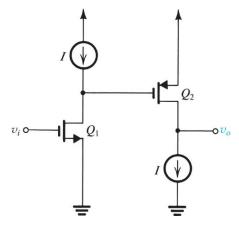


Figure 4.

Répondez aux questions suivantes en expliquant bien votre raisonnement.

- (a) Dessinez le modèle petit signal de ce circuit.
- (b) Donnez l'impédance vue dans le drain de Q₁.
- (c) Donnez l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie du circuit.
- (d) Donnez l'expression du gain v_o/v_i en fonction des paramètres petit signal du circuit.
- (e) Déterminez la plage de tensions d'entrée $v_{i_min} < v_i < v_{i_max}$.
- (f) Déterminez la plage de tensions de sortie $v_{o_min} < v_o < v_{o_max}$.
- (g) Utilisez un étage cascode pour augmenter le gain de ce circuit.
 - i. Redessinez le circuit avec son étage cascode.
 - ii. Donnez le gain et l'impédance de sortie de ce nouveau circuit.

3. (40 points) Conception d'un amplificateur opérationnel CMOS

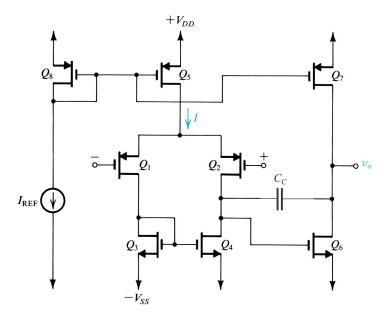


Figure 5.

L'ampli-op montré ci-dessus possède les caractéristiques suivantes : $V_{DD} = V_{SS} = 1.8 \text{ V}$, $V_{tn} = |V_{tp}| = 0.6 \text{ V}$, $\mu_n C_{ox} = 200 \text{ }\mu\text{A}/\text{V}^2$ et $\mu_p C_{ox} = 50 \text{ }\mu\text{A}/\text{V}^2$ et V_A = 18 V/ μ m. Utilisez $L = 1 \text{ }\mu\text{m}$ et $V_{OV} = 0.25 \text{ V}$ pour tous les MOSFET. **Notez que W**₅ = **320 \mum**, **W**₇ = **160 \mum et que I**_{REF} = **100 \muA**.

- (a) Donnez la fonction de chaque transistor $(Q_1 \grave{a} Q_8)$.
- (b) Calculez les courants I_D et les W/L de tous les transistors.
- (c) Calculez les g_m et les r_o de tous les transistors.
- (d) Calculez le gain en boucle ouverte (v_0/v_i) et la résistance de sortie de cet ampli-op.
- (e) Déterminez sa plage de tension d'entrée en mode commun v_{icm min}<v_{icm}<v_{icm max}.
- (f) Déterminez sa plage de tension de sortie $v_{o_min} < v_o < v_{o_max}$.
- (g) Calculez le taux de rejet du mode commun de cet ampli-op.
- (h) Dessinez le diagramme de Bode approximatif du gain v_o/v_i et situez le premier pôle. Expliquez la cause de ce pôle en fonction des paramètres petit signal et des nœud internes de l'ampli-op.

Bonne chance!

Benoit Gosselin

Aide mémoire

Courant de drain et paramètres petit signal du MOSFET

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D}$$

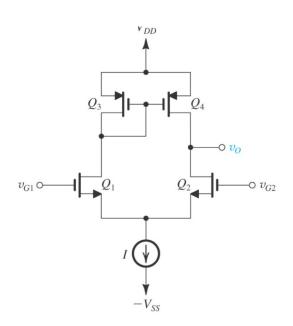
$$g_{m} = \frac{2I_{D}}{V_{OV}},$$
 $g_{m} = \frac{1}{2}\mu_{n}C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{t}),$ $g_{m} = \sqrt{2\mu_{n}C_{ox}(W/L)I_{D}}$

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)I_D}$$

$$V_{GS} = V_{tn} + \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox}(W/L)}}$$

Paire différentielle

$$A_{cm} = \frac{v_o}{v_{icm}} = \frac{r_{o4}}{2R_{ss}} \frac{1}{1 + g_{m3}r_{o3}}$$



Modèle petit signal de l'ampli-op à 2 étages

